

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor polowy MOS kanał typu N, o dużej rezystancji wejściowej, w obudowie metalowej

Zastosowanie: wzmacniacze, przełączające układy impulsowe

Typy podobne: 3SK21 (Hit)

Rys. 1-789. KF521

Wartości charakterystyczne¹⁾

| | | | | |
|--------------|--------|-----|------------|--|
| U_{DS} | 30 | 20 | V | przy $I_D = 10 \mu A$, $U_{GS} = -6 V$ |
| $-U_T$ | 3 | 5 | V | przy $I_{DS} = 10 \mu A$, $U_{DS} = 6 V$ |
| $-I_{GSS}$ | | 4 | pA | przy $U_{GS} = -20 V$, $U_{DS} = 0$ |
| I_{DSS} | 4 ÷ 10 | | mA | przy $U_{DS} = 6 V$, $U_{GS} = 0$ |
| y_{21e} | 3,5 | 2,5 | mA/V | przy $U_{DS} = 6 V$, $I_{DS} = 5 mA$, $f = 1 kHz$ |
| C_{11e} | 3 | | pF | przy $U_{DS} = 6 V$, $U_{GS} = 0$, $f = 1 MHz$ |
| $r_{DS ON}$ | 230 | 300 | Ω | przy $U_{DS} = 0,1 V$, $U_{GS} = 0$ |
| $r_{DS OFF}$ | 1000 | 100 | M Ω | przy $U_{DS} = 0,1 V$, $U_{GS} = -6 V$ |
| U_n | 0,1 | | μV | przy $U_{DS} = 6 V$, $I_{DS} = 5 mA$, $f = 1 kHz$ |
| $1/g_{11e}$ | | 200 | k Ω | } przy $U_{DS} = 6 V$, $U_{GS} = 0$, $f = 10 MHz$ |
| c_{11e} | | 2,8 | pF | |
| $1/g_{12e}$ | | 200 | k Ω | |
| c_{12e} | | 0,6 | pF | |
| $1/g_{22e}$ | | 10 | k Ω | |
| c_{22e} | | 2,5 | pF | |
| $1/g_{11e}$ | | 100 | k Ω | } przy $U_{DS} = 6 V$, $U_{GS} = 0$, $f = 100 MHz$ |
| c_{11e} | | 2,8 | pF | |
| $1/g_{12e}$ | | 100 | k Ω | |
| c_{12e} | | 0,6 | pF | |
| $1/g_{22e}$ | | 6 | k Ω | |
| c_{22e} | | 2,5 | pF | |

¹⁾ $t_{amb} = \sim 25^\circ C$

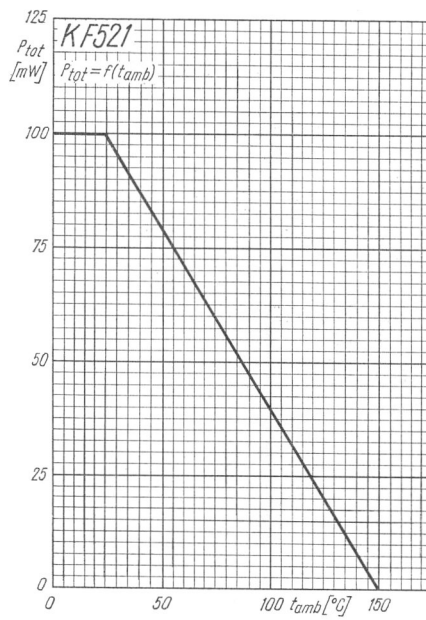
KF521

Wartości graniczne¹⁾

| | | | | | |
|----------------|------------------|----|----------------|------------|----|
| $U_{GSM \max}$ | ± 20 | V | $P_{tot \max}$ | 100 | mW |
| U_{DSM} | 20 ²⁾ | V | $t_{j \max}$ | 150 | °C |
| $I_{DSM \max}$ | 10 | mA | t_{stg} | -55 ÷ +150 | °C |

¹⁾ $t_{amb} = \sim 25^\circ\text{C}$

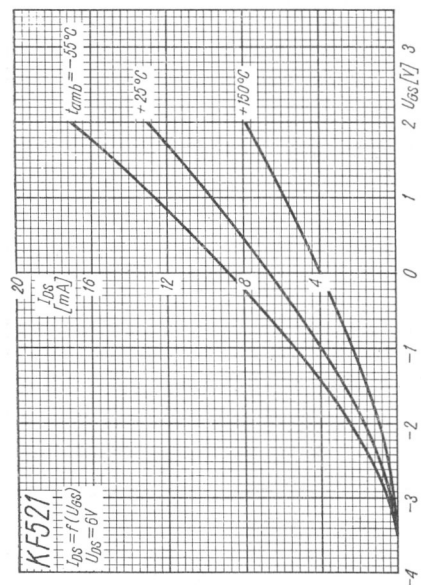
²⁾ $U_{GS} = -6 \text{ V}$



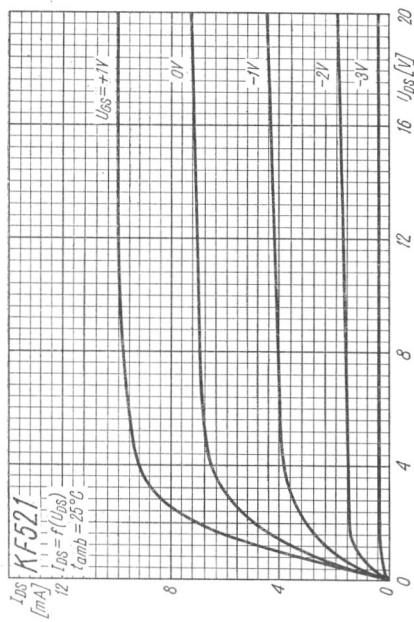
Rys. 1-790. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia



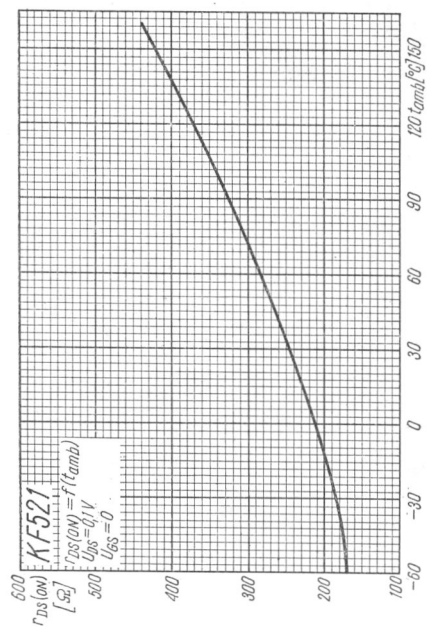
Rys. 1-791. Charakterystyki przejściowe



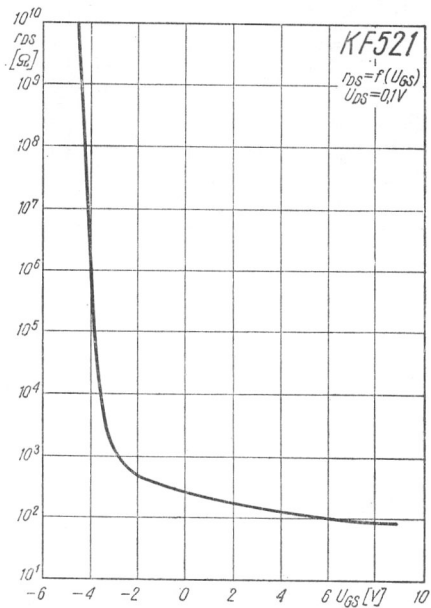
Rys. 1-792. Charakterystyki przejściowe



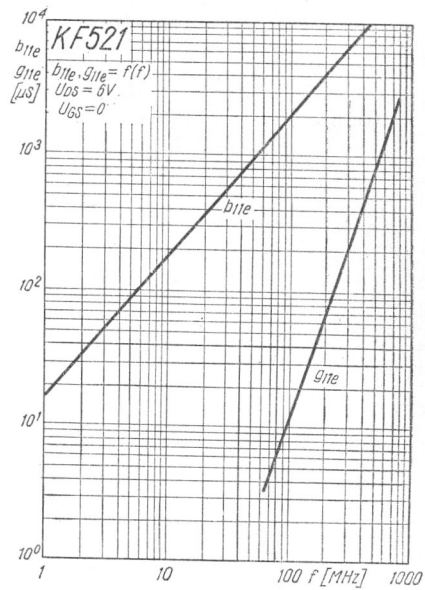
Rys. 1-793. Charakterystyki statyczne



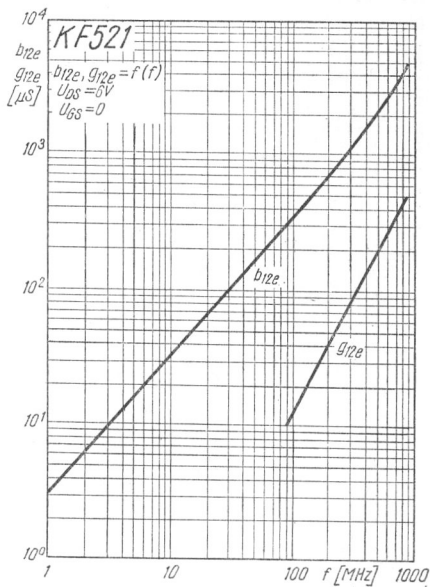
Rys. 1-794. Zależność rezystancji r_{DS} od temperatury otoczenia



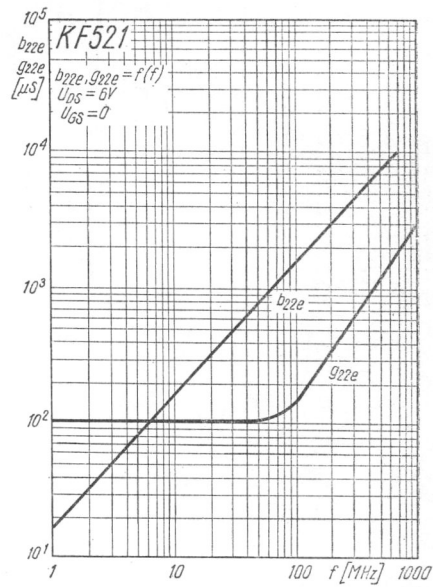
Rys. 1-795. Zależność rezystancji r_{DS} od napięcia bramki



Rys. 1-796. Zależność parametrów b_{11e} i g_{11e} od częstotliwości



Rys. 1-797. Zależność parametrów b_{12e} i g_{12e} od częstotliwości



Rys. 1-798. Zależność parametrów b_{22e} i g_{22e} od częstotliwości